

# 109 年度工研院 半導體光源、封裝及影像技術等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含半導體光源、封裝及影像技術等相關專利 94 案 148 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」共分為五個類別：（一）半導體光源技術（29 案 55 件）、（二）半導體封裝技術（22 案 38 件）、（三）影像技術（23 案 32 件）、（四）半導體記憶體技術（17 案 19 件）及（五）軟性電子技術（3 案 4 件）。

「讓與標的」中之案次 1、11、12、92、93 係與第三人共有（以下簡稱「共有標的」）。部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果。詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>）、及工研院研發成果公告網站（<https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=12&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372>）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）109 年 3 月 4 日 15 時整於工研院中興院區 51 館 108 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 3 月 2 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「半導體光源、封裝及影像技術等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 3 月 3 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

3. 自本標案公告日起至截標日 109 年 3 月 17 日下午 5 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

#### 五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件(如公司登記證明文件、商業登記證明文件、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「半導體光源、封裝及影像技術等相關專利讓與案」並標示出欲投標的技術類別(共五類)，於截標日 109 年 3 月 17 日下午 5 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

#### 六、重要事項：

請投標人注意：「共有標的」係與第三人共有。故，「共有標的」之讓與，須經共有人同意後，始生效力。

#### 七、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

#### 八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，

若於決標前未能補足者，其投標為無效。

#### 九、決標方法：

1. 開標日為 109 年 3 月 18 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家(含)以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

#### 十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」中之科專成果之讓與，須報經濟部同意後生效。另，得標廠商充分了解「共有標的」之讓與，須經共有人同意。此外，工研院對於共有人及經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生

效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)為一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關核准及同意後始得為之：
  - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
  - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄

區域外製造或使用者；

(3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

(4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止全部或部分「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：

(1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。

(3) 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15. 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 16 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

17. 得標廠商於「讓與契約書」生效後，因股權變動而產生或增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，應於事實發生後 30 日內，以書面通知工研院。若前述「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展時，工研院得以書面通知

得標廠商後解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：[iris.lin@itri.org.tw](mailto:iris.lin@itri.org.tw)

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：讓與標的清單 (94 案 148 件)

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬類	專利起期	專利迄期	契約運用
(一)半導體 光源技術 (29 案 55 件)	LED (27 案 53 件)	1	P03940176TW	主動式有機發光二極體之畫素結構及其製造方法	獲證	台灣	I292281	科發專明	20080101	20251228	共有
			P03940176USD1	主動式有機發光二極體之畫素結構及其製造方法	獲證	美國	7,575,966	科發專明	20090818	20260302	共有
		2	P03930019TW	側置式裸晶發光二極體及其組成之背光模組	獲證	台灣	I236166	自有發明	20050711	20240802	非專授權中
			P03930019US	側置式裸晶發光二極體及其組成之背光模組	獲證	美國	7,312,478	自有發明	20071225	20250523	非專授權中
			P03930019USC1	側置式裸晶發光二極體及其組成之背光模組	獲證	美國	7,375,384	自有發明	20080520	20241228	非專授權中
		3	P03930128TW	備有發光二極體及光學突出物的光源	獲證	台灣	I243494	自有發明	20051111	20250317	非專授權中
			P03930128US	備有發光二極體及光學突出物的光源	獲證	美國	7,205,719	自有發明	20070417	20251117	非專授權中
		4	P51000080TW	發光元件及其製作方法	獲證	台灣	I443876	科發專明	20140701	20311115	
		5	P51960115TW	發光元件	獲證	台灣	I459583	科發專明	20141101	20271120	
			P51960115US	發光元件	獲證	美國	8,378,567	科發專明	20130219	20290227	
		6	P51970054TW	發光裝置	獲證	台灣	I398020	科發專明	20130601	20281130	
			P51970054CN	發光裝置	獲證	中國	ZL200810185203.7	科發專明	20140101	20281217	
			P51970054USD1	發光裝置	獲證	美國	8,410,503	科發專明	20130402	20290310	
		7	P51980139TW	發光單元陣列、用以製造其之方法及成像裝置	獲證	台灣	I424251	科發專明	20140121	20301005	
			P51980139CN	發光單元陣列、其製造方法和投影設備	獲證	中國	ZL201080010263.0	科發專明	20150916	20300621	
			P51980139US	發光單元陣列、用以製造其之方法及成像裝置	獲證	美國	8,573,784	科發專明	20131105	20300611	
		8	P51000012TW	照明裝置	獲證	台灣	I422784	科發專明	20140111	20310811	

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(一)半導體 光源技術 (29案55件)	LED (27案53 件)	9	P51000012CN	照明裝置	獲證	中國	ZL2011102 66774.5	科專	發明	2014 1126	2031 0908	
			P51000097TW	照明控制裝置和方法	獲證	台灣	I459330	自有	發明	2014 1101	2031 1228	
		10	P51000110TW	發光裝置	獲證	台灣	I449466	科專	發明	2014 0811	2031 1225	
			P51000110US	發光裝置	獲證	美國	9,210,754	科專	發明	2015 1208	2033 0726	
		11	P51060021TW	可攜式淨化裝置	獲證	台灣	I636964	自有	發明	2018 1001	2037 1019	共有
			P51060021CN	可攜式淨化裝置	審 查 中	中國	201711258 525.5	自有	發明			共有
			P51060021US	可攜式淨化裝置	審 查 中	美國	15/869,101	自有	發明			共有
		12	P51970062TWC1	發光二極體之PN接面溫度的測試方法	獲證	台灣	I404923	科專	發明	2013 0811	2028 1201	共有
			P51970062US	交流發光二極體PN接面之溫度測試方法	獲證	美國	7,982,486	科專	發明	2011 0719	2029 0701	共有
		13	P51970088TW	發光二極體晶片及其製作方法	獲證	台灣	I446571	科專	發明	2014 0721	2028 1013	
		14	P51970131TW	氮化物半導體結構及其製造方法	獲證	台灣	I386981	科專	發明	2013 0221	2029 0322	
		15	P51970143TW	氮化物半導體發光二極體元件	獲證	台灣	I384657	科專	發明	2013 0201	2029 0714	
		16	P51970158TW	發光二極體封裝結構與其製作方法	獲證	台灣	I474502	科專	發明	2015 0221	2029 0329	
		17	P51980045TW	氮化物半導體模板及其製作方法	獲證	台灣	I397618	科專	發明	2013 0601	2030 1003	
			P51980045CN	氮化物半導體模板及其製作方法	獲證	中國	ZL2010106 06225.3	科專	發明	2014 0402	2030 1223	
			P51980045US	氮化物半導體模板及其製作方法	獲證	美國	8,648,387	科專	發明	2014 0211	2030 0917	
		18	P51980140CN	背光模塊、面光源模塊及導光網格結構	獲證	中國	ZL2010101 94106.1	科專	發明	2013 1009	2030 0527	

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(一)半導體 光源技術 (29案55件)	LED (27案53 件)	19	P51980146TW	照明裝置	獲 證	台 灣	I402456	科 專	發 明	2013 0721	2030 0316	
		20	P51980148TW	發光二極體晶片、包含其 之封裝結構以及其製造方 法	獲 證	台 灣	I422065	科 專	發 明	2014 0101	2030 1230	非專授權中
			P51980148CN	發光二極管晶片、發光二 極管封裝結構、及用以形 成上述的方法	獲 證	中 國	ZL2010800 69451.0	科 專	發 明	2017 0329	2030 0802	
			P51980148CNA1	發光二極管晶片、發光二 極管封裝結構、及其形成 方法	獲 證	中 國	ZL2011800 47417.8	科 專	發 明	2016 0803	2031 0802	
			P51980148USA3	發光二極體晶片、包含其 之封裝結構以及其製造方 法	獲 證	美 國	8,759,865	科 專	發 明	2014 0624	2031 0802	
			21	P51990003TW	發光二極體晶片及其製造 方法	獲 證	台 灣	I393270	科 專	發 明	2013 0411	2030 0513
		22	P51990032TW	發光二極體封裝、發光二 極體模組與發光二極體燈	獲 證	台 灣	I447973	科 專	發 明	2014 0801	2030 1228	曾非專屬授權
			P51990032CN	發光二極管封裝、發光二 極管模塊及發光二極管燈	獲 證	中 國	ZL2011100 05934.0	科 專	發 明	2013 0807	2031 0106	曾專屬授權
			P51990032USA1	發光二極體封裝、發光二 極體模組與發光二極體燈	獲 證	美 國	8,455,888	科 專	發 明	2013 0604	2031 0821	曾專屬授權
			P51990032USA2	發光二極體封裝、發光二 極體模組與發光二極體燈	獲 證	美 國	8,502,250	科 專	發 明	2013 0806	2031 0817	曾專屬授權
		23	P51990035TWC1	光色調制方法、發光二極 體光源模組及其封裝結構	獲 證	台 灣	I452670	科 專	發 明	2014 0911	2031 0123	
			P51990035CN	光色調制方法及發光二極 管光源模塊	獲 證	中 國	ZL2010106 23169.4	科 專	發 明	2014 0122	2030 1228	
		24	P51990092CN	氮化物半導體發光二極管 元件	獲 證	中 國	ZL2011100 83184.9	科 專	發 明	2014 1203	2031 0401	
			P51990092US	氮化物半導體發光二極管 元件	獲 證	美 國	8,362,458	科 專	發 明	2013 0129	2031 0615	
		25	P51990118TW	氮化物半導體結構	獲 證	台 灣	I433354	科 專	發 明	2014 0401	2030 1229	
		26	P51990119TW	微光環境照明系統	獲 證	台 灣	I424150	科 專	發 明	2014 0121	2030 1230	

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(一)半導體 光源技術 (29案55件)	LED (27案53 件)		P51990119CN	微光環境照明系統	獲 證	中 國	ZL2011100 50892.2	科 專	發 明	2014 0514	2031 0228	
			P51990119US	微光環境照明系統	獲 證	美 國	8,508,138	科 專	發 明	2013 0813	2031 1029	
		27	P51990122US	可撓式光源模組	獲 證	美 國	8,636,381	科 專	發 明	2014 0128	2032 0526	
	其他 (2案2件)	28	P51960131TWD1	充電裝置	獲 證	台 灣	I489731	自 有	發 明	2015 0621	2028 0113	
		29	P51960155TW	光電互連模組	獲 證	台 灣	I402549	科 專	發 明	2013 0721	2028 0408	
(二)半導體 封裝技術 (22案38件)	晶圓級構 裝/3D構 裝 (9案17 件)	30	P03910069TW	自組裝奈米導電凸塊及其 製造方法	獲 證	台 灣	200159	科 專	發 明	2004 0401	2022 1107	非專授權中
			P03910069US	自組裝奈米導電凸塊及其 製造方法	獲 證	美 國	6,989,325	科 專	發 明	2006 0124	2023 0902	非專授權中
		31	P03920070TW	影像感測器之封裝結構與 方法	獲 證	台 灣	I242269	科 專	發 明	2005 1021	2024 0309	非專授權中、 曾非專屬授權
			P03920070USC1	影像感測器之封裝結構與 方法	獲 證	美 國	7,417,293	科 專	發 明	2008 0826	2024 0426	非專授權中、 曾非專屬授權
			P03920070USD1	一種影像感測器構裝的結 構與製程方法	獲 證	美 國	7,544,529	科 專	發 明	2009 0609	2024 0720	非專授權中、 曾非專屬授權
		32	P03930086TW	薄型化電子構裝結構及其 製作方法	獲 證	台 灣	I241695	科 專	發 明	2005 1011	2024 1118	非專授權中
		33	P03930174TW	熱增益型薄型化電子構裝	獲 證	台 灣	I283553	科 專	發 明	2007 0701	2025 0420	非專授權中
			P03930174CN	熱增益型薄型化電子構裝	獲 證	中 國	ZL2005100 74627.2	科 專	發 明	2009 0211	2025 0524	非專授權中
			P03930174US	熱增益型薄型化電子構裝	獲 證	美 國	7,511,365	科 專	發 明	2009 0331	2025 1212	非專授權中
			P03930174USD1	熱增益型薄型化電子構裝	獲 證	美 國	7,754,530	科 專	發 明	2010 0713	2025 1212	曾非專屬授權
		34	P51000172TW	晶片堆疊結構以及晶片堆 疊結構的製作方法	獲 證	台 灣	I485826	科 專	發 明	2015 0521	2032 0524	
			P51000172US	晶片堆疊結構以及晶片堆 疊結構的製作方法	獲 證	美 國	8,519,524	科 專	發 明	2013 0827	2032 0815	
		35	P51980127TW	電子元件封裝結構及其製 造方法	獲 證	台 灣	I414047	科 專	發 明	2013 1101	2030 0316	

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(二)半導體 封裝技術 (22案38件)	晶圓級構 裝/3D構 裝 (9案17 件)		P51980127US	電子元件封裝結構及其製 造方法	獲 證	美 國	8,598,686	科 專	發 明	2013 1203	2031 1220	
		36	P51000159TW	具有矽穿孔之雙重鑲嵌結 構及其製造方法	獲 證	台 灣	I441281	科 專	發 明	2014 0611	2032 0411	
		37	P51980041TW	三維多層堆疊半導體結構 及其製造方法	獲 證	台 灣	I405321	科 專	發 明	2013 0811	2029 0907	
		38	P51990079TW	半導體結構及其製作方法	獲 證	台 灣	I453864	科 專	發 明	2014 0921	2030 1111	
	電子構裝 (8案14 件)	39	P03920101US	光電傳輸模組及其製造方 法	獲 證	美 國	7,046,871	科 專	發 明	2006 0516	2025 0104	
		40	P51000015TW	熱電模組	獲 證	台 灣	I424595	科 專	發 明	2014 0121	2031 0725	
		41	P51000067TW	電子元件封裝結構	獲 證	台 灣	I489601	科 專	發 明	2015 0621	2031 1218	
			P51000067US	電子元件封裝結構	獲 證	美 國	8,536,701	科 專	發 明	2013 0917	2032 0304	
		42	P51000168TW	自組裝設備、使元件自組 裝的方法以及熱電元件組 裝方法	獲 證	台 灣	I440059	科 專	發 明	2014 0601	2032 0509	
			P51000168CN	自組裝設備、使元件自組 裝的方法以及熱電元件組 裝方法	獲 證	中 國	ZL2012102 12665.X	科 專	發 明	2015 0916	2032 0620	
			P51000168US	自組裝設備、使元件自組 裝的方法以及熱電元件組 裝方法	獲 證	美 國	8,609,454	科 專	發 明	2013 1217	2032 0716	
		43	P51950065TW	具散熱結構之發光二極體 光源模組	獲 證	台 灣	I363161	自 有	發 明	2012 0501	2026 0725	非專授權中
			P51950065CND1	具有散熱結構之發光二極 管光源模塊	獲 證	中 國	ZL2010101 05332.8	自 有	發 明	2012 0509	2026 0814	
			P51950065US	具散熱結構之發光二極體 光源模組	獲 證	美 國	7,586,126 C1	自 有	發 明	2009 0908	2026 0911	非專授權中
		44	P51990050TW	功率元件封裝結構	獲 證	台 灣	I424550	科 專	發 明	2014 0121	2030 1229	
			P51990050US	功率元件封裝結構	獲 證	美 國	8,525,328	科 專	發 明	2013 0903	2031 1011	

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用	
(二)半導體 封裝技術 (22案38件)	電子構裝 (8案14 件)	45	P51960039TW	光電混載電路板及其製造 方法	獲 證	台 灣	I393509	科 專	發 明	2013 0411	2027 0703		
		46	P51970085TW	光波導結構及其製造方法	獲 證	台 灣	I393928	科 專	發 明	2013 0421	2028 1118		
	基板與被 動元件 (5案7 件)	47	034890145AUS	子母貫通孔結構	獲 證	美 國	6,717,071	科 專	發 明	2004 0406	2021 0315	非專授權中、 曾非專屬授權	
		48	034900017US	具低切換雜訊的構裝結構	獲 證	美 國	6,683,781	科 專	發 明	2004 0127	2022 0522		
		49	P03920014US	具內藏電容之基板結構	獲 證	美 國	7,064,427	科 專	發 明	2006 0620	2024 0825		
		50	P03930035US	細糜多層式平衡轉非平衡 訊號轉換器	獲 證	美 國	7,068,122	科 專	發 明	2006 0627	2024 0927		
		51	P51000130TW	電感結構	獲 證	台 灣	I442422	科 專	發 明	2014 0621	2032 0118		
			P51000130CN	電感結構	獲 證	中 國	ZL2012101 68092.5	科 專	發 明	2016 0413	2032 0524		
			P51000130US	電感結構	獲 證	美 國	8,686,821	科 專	發 明	2014 0401	2032 0618		
	(三) 影像技術 (23案32件)	3D 影像 (20案29 件)	52	084890085US	三維形狀掃描系統	獲 證	美 國	6,480,287	科 專	發 明	2002 1112	2021 0226	
			53	P51000013TW	立體顯示模組、其製作方 法及其製作系統	獲 證	台 灣	I432783	科 專	發 明	2014 0401	2031 1025	
P51000013US				立體顯示模組、其製作方 法及其製作系統	獲 證	美 國	8,520,176	科 專	發 明	2013 0827	2032 0322		
54			P51000107US	顯示裝置	獲 證	美 國	8,743,038	科 專	發 明	2014 0603	2032 1121		
55			P51970023US	以資料庫為基礎之二維影 像轉為三維影像內容之轉 換方法、其電腦可讀取媒 體以及影像轉換系統	獲 證	美 國	8,411,932	科 專	發 明	2013 0402	2032 0202		
56			P51970115TW	濾波器設計方法、裝置與 用濾波器還原影像的方法 及裝置	獲 證	台 灣	I434228	科 專	發 明	2014 0411	2029 0116		
			P51970115US	濾波器設計方法、裝置與 用濾波器還原影像的方法 及裝置	獲 證	美 國	8,452,115	科 專	發 明	2013 0528	2032 0109		

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(三) 影像技術 (23案32件)	3D 影像 (20案29 件)	57	P51970137TW	全域極小值的搜尋方法及系統	獲證	台灣	I413020	科專	發明	2013 1021	2028 1230	
			P51970137US	全域極小值的搜尋方法及系統	獲證	美國	8,457,388	科專	發明	2013 0604	2032 0320	
		58	P51980049TW	立體顯示器以及顯示器	獲證	台灣	I408664	科專	發明	2013 0911	2029 0810	
			P51980049US	立體顯示器以及顯示器	獲證	美國	8,508,526	科專	發明	2013 0813	2028 0621	
		59	P51980078TW	自我定位裝置及其方法	獲證	台灣	I403690	科專	發明	2013 0801	2029 1025	
			P51980078US	自我定位裝置及其方法	獲證	美國	8,385,683	科專	發明	2013 0226	2031 0328	
		60	P51980079TW	三維物件的碰撞模擬方法	獲證	台灣	I412948	科專	發明	2013 1021	2029 1230	
		61	P51980080TW	產生立體影像之影像深度的方法	獲證	台灣	I398158	科專	發明	2013 0601	2029 1130	
		62	P51980089CN	微型成像模塊、應用之立體顯示系統及影像排列方法	獲證	中國	ZL2009102 66558.3	科專	發明	2013 0807	2029 1228	
			P51980089US	微型成像模塊、應用之立體顯示系統及影像排列方法	獲證	美國	8,723,929	科專	發明	2014 0513	2032 0730	
		63	P51980098TW	多視角影像之建構方法及系統	獲證	台灣	I387934	科專	發明	2013 0301	2029 1230	
		64	P51980101TW	距離估算方法及其距離估算裝置，及其機器可讀取媒體	獲證	台灣	I441095	科專	發明	2014 0611	2030 0928	
			P51980101US	距離估算方法及其距離估算裝置，及其機器可讀取媒體	獲證	美國	8,406,510	科專	發明	2013 0326	2031 0329	
		65	P51990020CN	雙模式圖像顯示裝置及圖像亮度調整方法	獲證	中國	ZL2010102 99917.8	科專	發明	2013 1211	2030 0927	
66	P51990039TW	具有立體影像攝影引導的攝影系統與方法及自動調整方法	獲證	台灣	I433530	科專	發明	2014 0401	2030 1031			

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬	種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用	
(三) 影像技術 (23 案 32 件)	3D 影像 (20 案 29 件)	67	P51990053US	時間多工多畫面平行播放 立體顯示系統	獲 證	美 國	8,698,880	科 專	發 明	2014 0415	2032 0410		
		68	P51990060TWC1	前景深度地圖產生模組及 其方法	獲 證	台 灣	1469088	科 專	發 明	2015 0111	2031 0710		
			P51990060US	前景深度地圖產生模組及 其方法	獲 證	美 國	8,478,024	科 專	發 明	2013 0702	2032 0131		
		69	P51990069CN	立體顯示器	獲 證	中 國	ZL2011102 08174.3	科 專	發 明	2014 0409	2031 0718		
		70	P51990076US	投影式立體顯示器及立體 螢幕	獲 證	美 國	8,474,980	科 專	發 明	2013 0702	2031 0425		
		71	P51990130CN	量測方法與量測裝置	獲 證	中 國	ZL2011100 77221.5	科 專	發 明	2014 0730	2031 0324		
			P51990130US	量測方法與量測裝置	獲 證	美 國	8,767,094	科 專	發 明	2014 0701	2032 0627		
	其他 (3 案 3 件)	72	084890112US	多色階噴墨頭晶片結構	獲 證	美 國	6,457,808	科 專	發 明	2002 1001	2021 0822		
		73	P51960151TWC1	液體光學折光器與其製造 方法	獲 證	台 灣	1391710	科 專	發 明	2013 0401	2028 0908		
		74	P51990135TW	製造微陣列生物晶片的裝 置以及方法	獲 證	台 灣	1432727	科 專	發 明	2014 0401	2031 0427		
	(四)半導體 記憶體技術 (17 案 19 件)	記憶體 元件 (12 案 14 件)	75	034910059US	高密度磁性隨機存取記憶 體	獲 證	美 國	6,757,189	科 專	發 明	2004 0629	2023 0423	
			76	P03910091US	磁性隨機存取記憶體之參 考中點電流產生器	獲 證	美 國	6,791,887	科 專	發 明	2004 0914	2023 0903	
				P03910091USD	磁性隨機存取記憶體之參 考中點電流產生器	獲 證	美 國	6,862,228	科 專	發 明	2005 0301	2023 0903	
77			P51000003TW	電阻式隨機存取記憶體元 件及其製作方法	獲 證	台 灣	1451608	科 專	發 明	2014 0901	2031 0516		
78			P51960060TW	電阻式記憶體及其製造 方法	獲 證	台 灣	1393216	科 專	發 明	2013 0411	2027 1031		
79			P51970019USC1	電阻式記憶體及其製造方 法	獲 證	美 國	9,142,776	科 專	發 明	2015 0922	2029 0824		
			P51970019USC2	電阻式記憶體及其製造方 法	獲 證	美 國	9,373,789	科 專	發 明	2016 0621	2028 1211		
80	P51980012TW	交叉點型電阻式記憶體陣 列以及其製造方法	獲 證	台 灣	1431825	科 專	發 明	2014 0321	2029 0525				

技術分類	類別	案次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號/ 申請號	歸屬種類	專利 起期	專利 迄期	契約運用
(四)半導體 記憶體技術 (17 案 19 件)	記憶體 元件 (12 案 14 件)	81	P51980090TW	相變化記憶體裝置及其製造方法	獲證	台灣	I449170	科發 專明	2014 0811	2029 1228	
		82	P51980091TW	電阻式記憶元件及其製造方法	獲證	台灣	I433364	科發 專明	2014 0401	2029 1228	
		83	P51980116TW	電阻式記憶體驗證方法及其驗證裝置	獲證	台灣	I449050	科發 專明	2014 0811	2029 1230	
		84	P51980124TW	垂直式磁性磁阻元件結構	獲證	台灣	I398973	科發 專明	2013 0611	2029 1230	
		85	P51990006TW	電阻式記憶胞及其操作方法，以及電阻式記憶體及其操作方法與製造方法	獲證	台灣	I453896	科發 專明	2014 0921	2030 0728	
		86	P51990022TW	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	獲證	台灣	I399852	科發 專明	2013 0621	2030 0811	
	3DIC (2 案 2 件)	87	P51980034TW	三維積體電路晶片定址連接電路	獲證	台灣	I428931	科發 專明	2014 0301	2029 0928	
		88	P51990034TW	可測試直通矽晶穿孔的結構及方法	獲證	台灣	I401780	科發 專明	2013 0711	2030 0719	
	其他 (3 案 3 件)	89	P51960067TW	可撓式揚聲器結構	獲證	台灣	I406573	科發 專明	2013 0821	2027 0904	曾非專屬授權
		90	P51970036TW	三色膽固醇液晶之數位式資料電壓驅動電路及其方法	獲證	台灣	I398844	科發 專明	2013 0611	2028 0625	
		91	P51990134TW	影像感測器的像素電路	獲證	台灣	I433538	科發 專明	2014 0401	2031 0324	
(五)軟性電子 技術 (3 案 4 件)	軟性電子 技術 (3 案 4 件)	92	P61000003TW	觸控裝置及觸控面板	獲證	台灣	I450149	科發 專明	2014 0821	2031 1214	共有
		93	P61990097TW	多維度應力感測裝置及方法	獲證	台灣	I434033	科發 專明	2014 0411	2031 0906	共有
			P61990097US	多維度應力感測裝置及方法	獲證	美國	8,733,177	科發 專明	2014 0527	2032 0728	共有
		94	P51990113TW	光罩、曝光方法與曝光裝置	獲證	台灣	I444759	科發 專明	2014 0711	2030 1222	

【備註】：本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定 國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。